02;07

Обнаружение радиационных переходов между 4d⁹(²D_{5/2,3/2})5s²nl и 4d¹⁰5p(²P⁰_{1/2,3/2})nl автоионизационными состояниями атома кадмия при электрон-ионных столкновениях

© А.Н. Гомонай, А.И. Имре

Институт электронной физики НАН Украины, Ужгород E-mail: ovetex@mail.uzhgorod.ua, dep@mail.uzhgorod.ua

Поступило в Редакцию 3 августа 2004 г.

Впервые при электрон-ионных столкновениях обнаружены радиационные переходы между $4d^9(^2D_{5/2,3/2})5s^2nl$ и $4d^{10}5p(^2P_{1/2,3/2}^0)nl$ автоионизационными состояниями атома Cd, являющиеся диэлектронными сателлитами лазерных линий $\lambda 325.0\,nm~(4d^95s^2\,^2D_{3/2}\rightarrow 4d^{10}5p\,^2P_{1/2}^0)$ и $\lambda 353.6\,nm~(4d^95s^2\,^2D_{3/2}\rightarrow 4d^{10}5p\,^2P_{3/2}^0)$ иона Cd⁺. Исследованы энергетические зависимости эффективных сечений электронного возбуждения сателлитных линий в интервале энергий 7 \div 10 eV. Эффективные сечения возбуждения диэлектронных сателлитов составляют $\sim 10^{-17}\,\rm cm^2$, что сравнимо с эффективностью возбуждения собственно лазерных линий.

Спектроскопическая диагностика и надежное моделирование астрофизической и лабораторной плазмы требуют как качественных знаний, так и данных о количественных характеристиках и параметрах основных атомных процессов, в том числе и о столкновениях электронов с ионами. Среди процессов при электрон-ионных столкновениях в уравновешивании столкновительной ионизации положительных ионов в плазме низкой плотности важную роль играет диэлектронная рекомбинация ионов [1]. Она представляет собой захват свободного электрона ионом с образованием промежуточного автоионизационного состояния, которое затем распадается в радиационном канале в стабильное состояние атома (или иона, на заряд меньше в случае многозарядных ионов). Как показано в [2], радиационный распад автоионизационных состояний

69

может вдвое уменьшить вклад резонансов в сечение возбуждения для ионов с умеренным зарядом и еще сильнее — для многозарядных.

В условиях пересекающихся электронного и ионного пучков диэлектронная рекомбинация впервые была обнаружена для иона К⁺ [3], а впоследствии для ионов Cs⁺, Rb⁺ [4] и Tl⁺ [5]. Метод совпадений фотонов и ионов был успешно применен для исследования диэлектронной рекомбинации ионов Mg⁺ [6] и Ca⁺ [7]. Однако наблюдавшееся в этих экспериментах излучение соответствовало переходам, в которых только верхний уровень — автоионизационный, в то время как нижним уровнем является один из обычных уровней нейтрального атома (или иона на заряд меньше). К этому следует добавить, что пределами сходимости этих автоионизационных уровней были нижние резонансные уровни иона. Для автоионизационных состояний, сходящихся к более высоко лежащим уровням иона, открывается дополнительный канал радиационного распада на другие автоионизационные состояния, расположенные по энергии ниже. При электрон-атомных столкновениях были экспериментально обнаружены и исследованы радиационные переходы между автоионизационными состояниями атома лития [8]. Авторы [8] отмечали большую интенсивность спектральных линий, соответствующих таким переходам. Однако данные о переходах между автоионизационными состояниями при электрон-ионных столкновениях на данное время отсутствуют. Поэтому прямое экспериментальное исследование радиационных переходов между автоионизационными состояниями при столкновениях медленных электронов с ионами представляет фундаментальный интерес.

В данной работе приводятся результаты спектроскопического исследования впервые обнаруженных радиационных переходов между $4d^9(^2D_{5/2,3/2})5s^2nl$ и $4d^{10}5p(^2P^0_{1/2,3/2})nl$ автоионизационными состояниями атома Cd при столкновениях медленных электронов с ионами Cd⁺. Данные исследования имеют особый интерес и с прикладной точки зрения, поскольку излучаемые при этих переходах линии являются сателлитами лазерных $4d^95s^2{}^2D_{3/2} \rightarrow 4d^{10}5p{}^2P^0_{1/2,3/2}$ линий иона Cd⁺, на которых получена генерация с низким порогом возбуждения [9].

Эксперимент проведен на установке, подробно описанной в [10]. Низковольтный разрядный источник позволял получать стабильный пучок ионов с энергией 640 eV и током $(6 \div 8) \cdot 10^{-7}$ А. Величина разрядного напряжения $(U_p \leq 12 \text{ V})$ выбиралась из условия, чтобы она была заведомо меньше энергии возбуждения (17.6 eV) нижнего из

долгоживущих $4d^95s^2 {}^2D_{5/2,3/2}$ состояний иона Cd^+ . Тем самым значительно уменьшался излучательный фон, обусловленный радиационным распадом этих состояний. Треханодная электронная пушка в интервале энергий (7 ÷ 10) eV формировала ленточный пучок электронов с током 7 · 10⁻⁵ А и энергетической неоднородностью на полувысоте кривой распределения электронов по энергии $\Delta E_{1/2} = 0.35 \, \text{eV}$. Электронный и ионный пучки в области столкновений пересекались под прямым углом в условиях вакуума $\sim 10^{-8}$ Torr. Спектральное разделение излучения осуществлялось светосильным дифракционным монохроматором МДР-2 (1200 штр./mm), обратная линейная дисперсия которого составляла ~ 2 nm/mm. В качестве детектора излучения использовался охлаждаемый фотоэлектронный умножитель ФЭУ-140 ("Фотон"). Полезный сигнал $(1 \div 0.5 \text{ puls/s})$ накапливался циклически на протяжении 1000 ÷ 1500 s и выделялся из фона при помощи методики модуляции двух пучков прямоугольными фазосдвинутыми на 1/4 периода модуляции импульсами напряжения при соотношении сигнала к фону от 1/20 до 1/30. Процесс измерения и обработки экспериментальных данных был автоматизирован на базе персонального компьютера.

При прецизионном исследовании припороговых участков энергетических зависимостей эффективных сечений электронного возбуждения лазерных линий $\lambda = 325.0$ nm $(4d^95s^2\,^2D_{3/2} \rightarrow 4d^{10}5p\,^2P_{1/2}^0)$ и $\lambda = 353.6$ nm $(4d^95s^2\,^2D_{3/2} \rightarrow 4d^{10}5p\,^2P_{3/2}^0)$ иона Cd⁺ было обнаружено интенсивное излучение до порога их возбуждения (9.29 eV). Мы предположили, что это излучение связано с сателлитами этих линий. Для обеспечения четкого разделения собственно линий иона Cd⁺ от их сателлитов и максимального пропускания излучения сателлитных линий исследования проводились в интервалах длин волн $\lambda = 325.0 \pm 2$ nm и $\lambda = 353.6 \pm 2$ nm.

На рис. 1 представлены энергетические зависимости эффективных сечений возбуждения линий $\lambda = 325.0$ nm и $\lambda = 353.6$ nm иона Cd⁺ в интервале энергий электронов (7 ÷ 10) eV. Вертикальными отрезками на экспериментальных точках указаны среднеквадратичные ошибки измерений. Абсолютные значения эффективных сечений получены с погрешностью, не превышающей 15%, по методике, описанной в [10]. Расположение нижних уровней иона Cd⁺, а также сходящихся к ним автоионизационных состояний атома Cd, энергетические положения и конфигурации которых взяты из [11–13], приведено на рис. 2.



Рис. 1. Энергетические зависимости эффективных сечений электронного возбуждения диэлектронных сателлитов $4d^9({}^2D_{5/2,3/2})5s^2nl \rightarrow 4d^{10}5p({}^2P_{1/2,3/2}^0)nl$ $\lambda = 325.0 \pm 2 \text{ nm}(1)$ и $\lambda = 353.6 \pm 2 \text{ nm}(2)$ лазерных линий $\lambda = 325.0 \text{ nm}(4d^95s^2 {}^2D_{3/2} \rightarrow 4d^{10}5p {}^2P_{1/2}^0)(3)$ и $\lambda = 353.6 \text{ nm}(4d^95s^2 {}^2D_{3/2} \rightarrow 4d^{10}5p {}^2P_{3/2}^0)(4)$ соответственно.

Как видно из рис. 1, до порога возбуждения лазерных линий исследованные энергетические зависимости имеют форму максимума, расположенного в узком интервале энергий (от 8 до 9 eV), с максимальной эффективностью при энергии ~ 8.6 eV. Анализ полученных результатов и данных об автоионизационных состояниях атома кадмия позволяет утверждать, что эти максимумы связаны с радиационным распадом $4d^9(^2D_{5/2,3/2})5s^2nl$ автоионизационных состояний, образованных



Рис. 2. Диаграмма нижних уровней иона кадмия и сходящихся к ним автоионизационных состояний.

в результате резонансного захвата налетающего электрона с одновременным возбуждением одного из d-электронов, на $4d^{10}5p(^{2}P_{1/2,3/2}^{0})nl$ автоионизационных состояния:

$$e + \mathrm{Cd}^{+}(4\mathrm{d}^{10}5\mathrm{s})^{2}\mathrm{S}_{1/2} \to \mathrm{Cd}^{**}[4\mathrm{d}^{9}(^{2}\mathrm{D}_{5/2,3/2})5\mathrm{s}^{2}\mathrm{nl}]$$
$$\to \mathrm{Cd}^{**}[4\mathrm{d}^{10}5\mathrm{p}(^{2}\mathrm{P}_{1/2,3/2})\mathrm{nl}] + h\upsilon_{n}, \qquad (1)$$

т.е. механизмом возбуждения сателлитных линий является диэлектронная рекомбинация. Согласно правилам отбора, разрешены $4d^95s^2np \rightarrow 4d^{10}5pnp, 4d^95s^2ns \rightarrow 4d^{10}5pns$ и $4d^95s^2nd \rightarrow 4d^{10}5pnd$ радиационные переходы. В первом случае наиболее вероятно, что это переходы между автоионизационными состояниями с n = 7-9, расположенными в энергетическом интервале между $4d^95s^2{}^2D_{5/2}$ и $4d^95s^2{}^2D_{3/2}$ уровнями (рис. 2). Отметим, что соответствующие этим переходам линии могут быть диэлектронными сателлитами только лазерной линии

 $\lambda = 353.6$ nm. Радиационные переходы $4d^95s^2ns \rightarrow 4d^{10}5pns$ осуществляются главным образом между автоионизационными состояниями с n = 7-8, а переходы $4d^95s^2np \rightarrow 4d^{10}5pnd$ — между автоионизационными состояниями с n = 6, расположенными по энергии ниже $4d^95s^2D_{5/2}$ уровня. Причем в этом случае радиационный распад верхних автоионизационных состояний возможен на $4d^{10}5pns(nd)$ автоионизационные состояния, сходящиеся как к нижнему $5p^2P_{1/2}$, так и к верхнему $5p^2P_{3/2}$ резонансному уровню соответственно. В первом случае излучают диэлектронные сателлиты лазерной линии $\lambda 325.0$ nm, а во втором — линии $\lambda 353.6$ nm.

Таким образом, наши исследования показали, что при столкновениях медленных электронов с ионами Cd⁺ интенсивно излучают радиационные переходы между $4d^9(^2D_{5/2,3/2})5s^2nl$ и $4d^{10}5p(^2P^0_{1/2,3/2})nl$ автоионизационными состояниями атома Cd, являющиеся диэлектронными са-теллитами лазерных линий $\lambda = 325.0 \text{ nm} (4d^95s^2 \,{}^2D_{3/2} \rightarrow 4d^{10}5p \,{}^2P_{1/2}^0)$ и $\lambda = 353.6 \,\mathrm{nm} \, (4d^9 5 \mathrm{s}^{2\,2} \mathrm{D}_{3/2} \rightarrow 4d^{10} 5 \mathrm{p}^{2} \mathrm{P}^{0}_{3/2})$. Их эффективные сечения электронного возбуждения составляют в максимуме 4 · 10⁻¹⁷ и $1 \cdot 10^{-17} \, \text{cm}^2$ соответственно и сравнимы с эффективными сечениями возбуждения лазерных линий иона Cd⁺ [13]. Поскольку заселение верхних лазерных $4d^95s^2 {}^2D_{5/2}$ и $4d^95s^2 {}^2D_{3/2}$ уровней при электронионных столкновениях, как было обнаружено нами экспериментально [13] и рассчитано *R*-матричным методом в приближении сильной связи 15 каналов в работе [14], осуществляется преимущественно за счет резонансного вклада автоионизационных состояний (резонансного возбуждения), то очень важно принимать во внимание конкурирующий электронному распаду этих состояний канал — их радиационный распад в процессе диэлектронной рекомбинации, который может значительно уменьшить эффективное сечение резонансного возбуждения.

Список литературы

- [1] Hahn Yu. // Rep. Prog. Phys. 1997. V. 60. P. 691-759.
- [2] Атомы в астрофизике: Пер. с англ./Под ред. Ф.Г. Берка, В. Эйснера, Д. Хаммера, И. Персиваля. М.: Мир, 1986. 348 с.
- [3] Алексахин И.С., Запесочный А.И., Имре А.И. // Письма в ЖЭТФ. 1978. Т. 28. С. 576–579.
- [4] Запесочный А.И., Имре А.И., Алексахин И.С. и др. // ЖЭТФ. 1986. Т. 90. С. 1972–1981.

- [5] Гомонай А.Н., Имре А.И., Контрош Е.Э. // Опт. и спектр. 1996. Т. 81. № 1. С. 29–32.
- [6] Belic D.S., Dunn G.H., Morgan T.J., Mueller D.W., Timmer C. // Phys. Rev. Lett. 1983. V. 50. P. 339–356.
- [7] Williams J.F. // Phys. Rev. A. 1984. V. 29. N 5. P. 2936–2938.
- [8] Алексахин И.С., Богачев Г.Г., Запесочный И.П., Угрин С.Ю. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 40. С. 459–461.
- [9] Справочник по лазерам / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Сов. радио, 1978.
 Т. 1. 504 с.
- [10] Гомонай А.Н. // Опт. и спектр. 2003. Т. 94. № 4. С. 538-545.
- [11] Mansfield M.W.D. // Proc R. Soc. Lond. 1978. V. A362. P. 129-144.
- [12] Mansfield M.W.D., Murnane M.M. // J. Phys. B.: At. Mol. Phys. 1985. V. 18. P. 4223–4244.
- [13] Гомонай А.Н., Имре А.И. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. В. 18. С. 89–94.
- [14] Зацаринный О.И., Бандурина Л.О. // Опт. и спектр. 2000. Т. 89. № 4. С. 546-554.